

CARATTERISTICHE D'USCITA MOS

nMOS

REGIONE DI INTERDIZIONE (OFF):
 $v_{GS} < V_{TH}$

$$i_D = 0$$

REGIONE DI SATURAZIONE:
 $v_{GS} > V_{TH} \wedge v_{DS} > v_{GS} - V_{TH}$

$$i_D = \frac{\beta}{2} (v_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

REGIONE TRIODO (ON):
 $v_{GS} > V_{TH} \wedge v_{DS} < v_{GS} - V_{TH}$

$$i_D = \beta v_{DS} (v_{GS} - V_{TH} - \frac{v_{DS}}{2}) (1 + \lambda v_{DS})$$

pMOS

$$v_{SD} = -v_{DS} \wedge v_{SG} = -v_{GS}$$

REGIONE DI INTERDIZIONE (OFF):
 $v_{SG} < V_{TH}$

$$i_D = 0$$

REGIONE DI SATURAZIONE:
 $v_{SG} > V_{TH} \wedge v_{SD} > v_{SG} - V_{TH}$

$$i_D = \frac{\beta}{2} (v_{SG} - V_{TH})^2 (1 + \lambda v_{SD})$$

REGIONE TRIODO (ON):
 $v_{SG} > V_{TH} \wedge v_{SD} < v_{SG} - V_{TH}$

$$i_D = \beta v_{SD} (v_{SG} - V_{TH} - \frac{v_{SD}}{2}) (1 + \lambda v_{SD})$$

CARATTERISTICHE D'USCITA BJT

REGIONE DI INTERDIZIONE (OFF):
 $v_{BE} < V_\gamma$

$$i_C = 0$$

REGIONE ATTIVA:
 $v_{BE} \geq V_\gamma \wedge v_{CE} > v_{CE,sat}$

$$i_C = \beta I_S (e^{v_{BE}/V_T} - 1) \left(1 + \frac{v_{CE}}{V_A} \right)$$

REGIONE DI SATURAZIONE (ON):
 $v_{BE} \geq V_\gamma \wedge v_{CE} < v_{CE,sat}$

$$i_C = f(v_{BE}, v_{CE})$$

APPLICAZIONI TRANSISTORI MOS

ANALOGICHE

il transistore MOS si comporta da blocco funzionale analogico solo in **regione di saturazione**

può essere utilizzato come **AMPLIFICATORE**

DIGITALI

v_G può assumere due valori:
- ALTO ($v_G = V_{DD}$)
- BASSO ($v_G = 0$)
solo in **regioni ON e OFF**

può essere utilizzato come **INTERRUTTORE CONTROLLATO DA v_G**

nMOS

ON → $v_G = V_{DD}$

OFF → $v_G = 0$

pMOS

ON → $v_G = 0$

OFF → $v_G = V_{DD}$

LINEARIZZAZIONE E PICCOLO SEGNALE MOS

il transistore MOS è un dispositivo non-lineare come il diodo. Si può linearizzare nell'intorno di un punto di lavoro separando componenti di polarizzazione e di piccolo segnale

in quanto dispositivo a 2 porte, ha 4 variabili

porta ingresso

porta uscita

$$i_G = I_G + i_g = 0$$

$$v_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$$

$$i_D = I_D + i_d$$

$$v_{DS} = V_{DS} + v_{ds}$$

in regione di saturazione

$$i_D = \frac{\beta}{2} (v_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

LINEARIZZANDO IN UN PUNTO DI LAVORO $Q = (V_{GS}, V_{DS})$

$$i_g = 0, i_d = g_m v_{gs} + g_o v_{ds}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}} \cong \sqrt{2I_D\beta}$$

$$g_o \cong \lambda I_D$$

$$g_i = g_r = 0$$

LINEARIZZAZIONE E PICCOLO SEGNALE BJT

anche per il transistore BJT si può analogamente ricavare un circuito equivalente per il piccolo segnale

in regione attiva

LINEARIZZANDO IN UN PUNTO DI LAVORO $Q = (V_{BE}, V_{CE})$

$$i_b = g_\pi v_{be}, i_c = g_m v_{be} + g_o v_{ce}$$

$$g_\pi = \frac{I_B}{V_T}$$

$$g_m \cong \frac{I_C}{V_T}$$

$$g_o \cong \frac{I_C}{V_A}$$

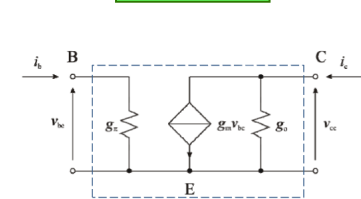
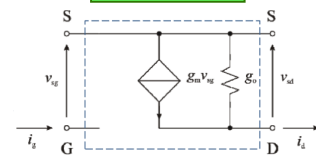
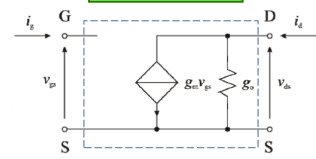
$$g_\mu \cong 0$$

CIRCUITI EQUIVALENTI PICCOLO SEGNALE

nMOS

pMOS

BJT



EFFETTI REATTIVI MOS

per segnali che variano rapidamente, si manifestano effetti reattivi, descrivibili con capacità parassite in generale non-lineari.

analisi nel dom. di Laplace

a bassa frequenza $|s| \rightarrow 0$

ad alta frequenza $|s| \rightarrow \infty$

il transistore si comporta sempre meno come un blocco funzionale analogico

